

## 本期封面



2000年2

栏目:

DOI:

论文题目: Ge<sub>x</sub>Si<sub>1-x</sub>材料生长的改善

作者姓名: 李代宗(1), 于卓(1), 雷霖霖(1, 2), 成步文(1), 余金中(1), 王启明(1)

工作单位: 1. 中国科学院半导体研究所集成光电子学国家重点实验室, 2. 中国科学院沈阳科学仪器研制中心

通信作者: 李代宗

通信作者Email:

文章摘要: 利用超高真空化学气相淀积(UHV/CVD)系统在650℃生长出表面光亮的GeSi单晶. 在1200L/min分子泵与前级机械泵间串接450L/min分子泵, 改善了生长环境. 串接分子泵后生长的样品的X射线双晶衍射分析表明, 外延层衍射峰半宽仅为198arcsec, 且出现了Pendellosung干涉条纹, 说明外延层结晶质量很好.

关键词: 超高真空化学气相淀积, GeSi, X射线双晶

分类号:

关闭